

BAS21

硅外延平面开关二极管芯片 (4 ")

■用途:

*用作高压、高速开关应用

■特征:

*正向压降低

*较短反向恢复时间

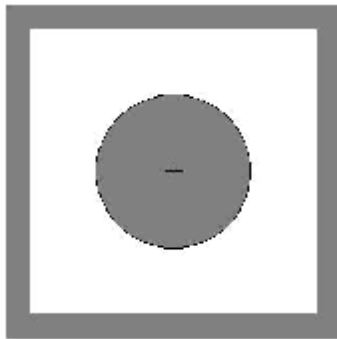
*用于片式封装

* 结电容小

*功率耗散 P_D : 225mW

*有效图形数: 78900

■芯片示意图



■芯片结构:

芯片尺寸	300 μ m \times 300 μ m
压焊区尺寸	ϕ 130 μ m
芯片厚度	180 \pm 10 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面: Al 2.3 \pm 0.2 μ m 背面: Au 1.4 \pm 0.2 μ m

■电特性 (Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	典型值	单位
反向电压	V_R	$I_R=0.1\text{mA}$	250		320	V
正向压降	$V_F(1)$	$I_F=100\text{mA}$		1.0	0.96	V
	$V_F(2)$	$I_F=200\text{mA}$		1.25	1.08	V
反向漏电流	I_R	$V_R=200\text{V}$		0.1		μ A
总电容	C_T	$V_R=0, f=1\text{MHZ}$		5.0		PF
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=I_R=30\text{mA}, I_{rr}=0.1 \times I_R$ $R_L=100 \Omega$		50	30	ns